

КТ399А

Предельные эксплуатационные данные

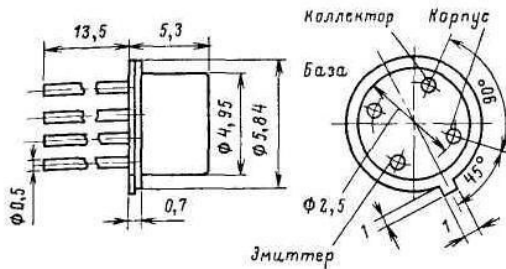
Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10$ кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	3 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Постоянный ток эмиттера	20 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$	40 мА
Импульсный ток эмиттера при $\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$	40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при $T = 213 - 328$ К, $p \leq 6650$ Па	150 мВт
при $T = 213 - 328$ К, $p = 665$ Па	105 мВт
при $T = 398$ К	39 мВт
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный *n-p-n* СВЧ усилительный с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц.

Предназначен для применения во входных и последующих каскадах усилителей высокой и сверхвысокой частот.

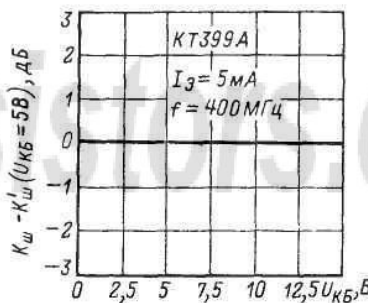
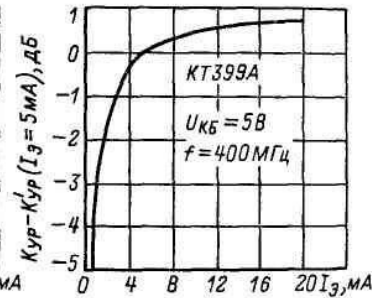
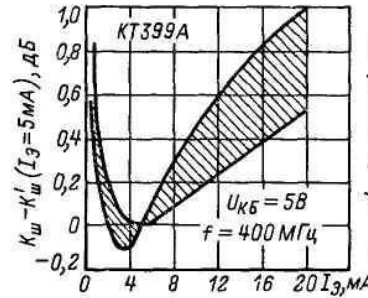
Выпускается в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА не менее	1.8 ГГц
типичное значение	2,4* - 2,9* ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА, $f = 30$ МГц не более	8 пс
типичное значение	6,2* пс
Минимальный коэффициент шума при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 400$ МГц не более	2 дБ
типичное значение	1,3* - 1,7* дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности* при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 400$ МГц	11,5 - 13,0 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 5$ мА	40
при $T = 298$ К не менее	80* - 170*
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15$ В, $T = 298$ К не более	0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при $T = 298$ К, $U_{КБ} = 3$ В не более	1 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более	1,7 пФ
типичное значение	1,5* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1$ В не более	3 пФ
типичное значение	2,1* - 2,6* пФ
Емкость конструктивная между выводом эмиттера и корпусом*	0,45 пФ
Емкость конструктивная между выводом коллектора и корпусом*	0,6 пФ
Емкость конструктивная между выводом базы и корпусом*	0,4 пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и базы*	0,15 пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и эмиттера*	0,08 пФ
Индуктивность выводов эмиттера и базы* при $l = 3$ мм	4,5 нГн

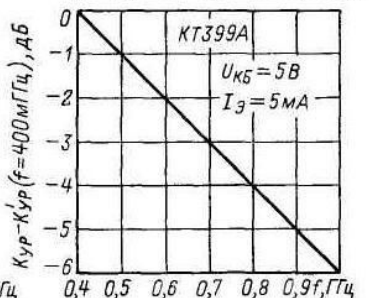
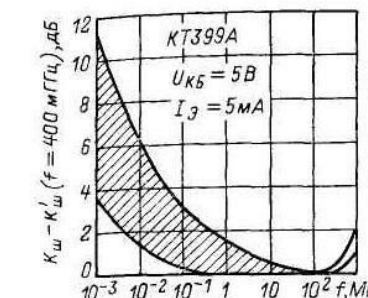
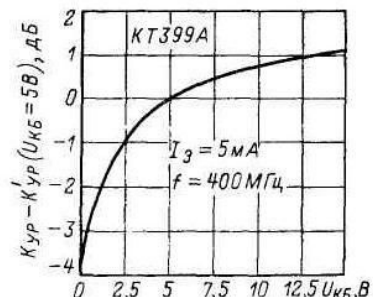


Зона возможных положений приведенной зависимости коэффициента шума от тока эмиттера

Приведенная зависимость коэффициента усиления по мощности от тока эмиттера

Приведенная зависимость коэффициента шума от напряжения коллектор-база

Приведенная зависимость коэффициента усиления по мощности от напряжения коллектор-база



Зона возможных положений зависимости коэффициента шума от частоты

Приведенная зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты